

Silicon Diode

BY193

Fast Rectifier

200V / 4A

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

BY 192...BY 195

Kennwerte

Nennstrom in Einwegschaltung mit Widerstandslast bei $T_G = 25\text{ °C}$	I_{FAV}	4	A
Durchlaßspannung bei $I_F = 3\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	u_F	<1,3	V
Sperrstrom bei U_{RRM} , $T_j = 25\text{ °C}$	I_R	<10	μA
Durchlaßverzögerung bei $I_F = 100\text{ mA}$	t_{fr}	<1	μs
Sperrverzögerung bei $T_G = 25\text{ °C}$ beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	<0,5	μs
Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse	R_{thG}	<5	K/W